







	<h2>R6030ENZ1C9</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6030ENZ1C9</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 30A TO247</p> <p>Datenblätter:  R6030ENZ1C9.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6030ENZ1C9
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 30A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 14.5A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

R6030ENZ1C9 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6030ENZ1C9-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6030ENZ1C9 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6030ENZ1C9 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R6030ENZ1C9 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO247</p>	 <p>R6030KNZC8 Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET</p>	 <p>R6030KNXC7 LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p>R6030KNZ1C9 Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET</p>
 <p>R6030835ESYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 800V 350A DO205AB</p>	 <p>R6030KNX Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET, TO220</p>	 <p>R6030635ESYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 600V 350A DO205AB</p>	 <p>R6030825HSYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 800V 250A DO205AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6030ENZ1C9 LAPIS Semiconductor	R6030ENZ1C9 Datenblatt	R6030ENZ1C9-Datenblätter	R6030ENZ1C9 PDF	LAPIS Semiconductor R6030ENZ1C9
R6030ENZ1C9 Electronic	R6030ENZ1C9-Komponenten	R6030ENZ1C9-Verteiler	R6030ENZ1C9-Bild	R6030ENZ1C9-Teil
R6030ENZ1C9 Preis	R6030ENZ1C9 Hersteller	R6030ENZ1C9 Bild	R6030ENZ1C9 Aktie	R6030ENZ1C9 Inventar
R6030ENZ1C9 Neu	R6030ENZ1C9 Original	R6030ENZ1C9 garantiert	R6030ENZ1C9 RFQ	R6030ENZ1C9 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited